

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
научного сотрудника
в лаборатории Физики профилированных кристаллов
Вакансия VAC 95057

Тематика исследований

Исследования структуры и свойств оксида и нитрида галлия.

Исследования структуры и свойств материалов с эффектом памяти формы и сверхупругости.

Трудовая деятельность

- технологии роста Ga₂O₃ из жидкой и газовой фазы;
- структура и фазовые переходы α-, β-, γ-, δ-, κ(ε)- фаз Ga₂O₃;
- прочностные свойства пленок и объемных образцов Ga₂O₃;
- трибологические свойства пленок и объемных образцов Ga₂O₃;
- морфология, фазовый и химический состава пленок оксида и нитрида галлия, определяемые с помощью электронной сканирующей микроскопии, рентгеноструктурного анализа и энергодисперсионной спектроскопии;
- химический и фазовый состав материалов с эффектом памяти формы, определяемые с помощью электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа;
- связи между структурой и комплексом свойств в материалах с эффектом памяти формы;
- характеристические температуры, величины обратимой деформации и генерируемых напряжений материалов с эффектом памяти формы.

- проведение научных исследований по указанным выше тематикам, включая сбор и анализ актуальной научно-технической информации;
- планирование проведения исследований, составление отчетов по проведенным исследованиям;
- анализ результатов экспериментальных данных;
- подготовка статей для публикации в ведущих мировых журналах, представление полученных результатов на семинарах и конференциях;
- проведение работы по регистрации результатов интеллектуальной собственности;
- участие в выполнении научно-исследовательских работ по проектам с научными фондами и Минобрнауки и др. ведомств РФ;
- участие в выполнении работ в рамках хозяйственных договоров с промышленными партнерами на выполнение за счёт их средств фундаментальных, поисковых и прикладных исследований;
- консультирование студентов и аспирантов, выполняющих НИР в лаборатории Физики профилированных кристаллов.

Требования к кандидату:

- наличие не менее 15 научных статей в рецензируемых физических журналах, индексируемых в базе SCOPUS и Web of science за последние 5 лет;
- владение английским языком на уровне, достаточном для чтения научно-технической литературы;
- умение и навыки работы с экспериментальными методиками, предназначенными для комплексного исследования материалов, таких как: электронная и оптическая микроскопия, рентгеноструктурный анализ, трибологические испытания, а также методики исследований физико-механических свойств материалов;
- опыт участия в грантах (РНФ, РФФИ).

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 26 180 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 18 000 руб.

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.